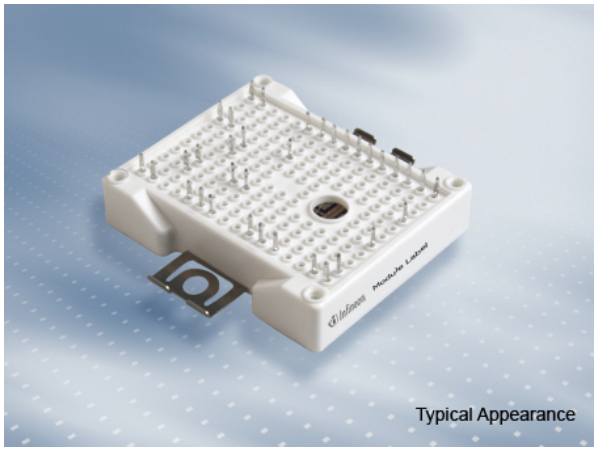
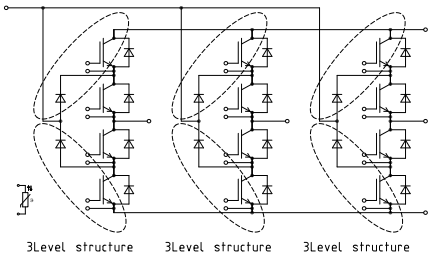
EasyPACK Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC

EasyPACK module with fast Trench/Fieldstop IGBT3 and Emitter Controlled 3 diode and PressFIT / NTC





V_{CES} = 650V
$I_{C\ nom}$ = 50A / I_{CRM} = 100A

Typische Anwendungen
- 3-Level-Applikationen
- Motorantriebe
- Solar Anwendungen
- USV-Systeme

Typical Applications
- 3-level-applications
- Motor drives
- Solar applications
- UPS systems

Elektrische Eigenschaften
- CoolSiC (TM) Schottky Diode Gen 5
- High Speed IGBT H3
- Niedrige Schaltverluste

Electrical Features
- CoolSiC (TM) Schottky diode gen 5
- High speed IGBT H3
- Low switching losses

Mechanische Eigenschaften
- 3 kV AC 1min Isolationsfestigkeit
- Al_2O_3 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
- Kompaktes Design
- PressFIT Verbindungstechnik
- Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern

Mechanical Features
- 3 kV AC 1min insulation
- Al_2O_3 substrate with low thermal resistance
- Compact design
- PressFIT contact technology
- Rugged mounting due to integrated mounting clamps

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

IGBT,Wechselrichter / IGBT,Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	650	V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	T_H = 25°C, $T_{vj\,max}$ = 175°C	$I_{C\,nom}$	50	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	100	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 25°C I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 125°C I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 150°C	$V_{CE\,sat}$		1,45 1,60 1,70	1,80	V V V
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	I_C = 0,80 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C	V_{GEth}	5,00	5,80	6,50	V
Gateladung Gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V	Q_G		0,50		µC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	T_{vj} = 25°C	R_{Gint}		0,0		Ω
Eingangskapazität Input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{ies}		3,10		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{res}		0,095		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 650 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C	I_{CES}			1,0	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C	I_{GES}			100	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 16 Ω, T_{vj} = 150°C	$t_{d\,on}$		0,037 0,037 0,037		µs µs µs
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 16 Ω, T_{vj} = 150°C	t_r		0,042 0,044 0,047		µs µs µs
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 16 Ω, T_{vj} = 150°C	$t_{d\,off}$		0,255 0,28 0,28		µs µs µs
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 16 Ω, T_{vj} = 150°C	t_f		0,058 0,064 0,066		µs µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 35 nH, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, di/dt = 1100 A/µs (T_{vj} = 150°C), T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 16 Ω, T_{vj} = 150°C	E_{on}		0,96 1,20 1,25		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 35 nH, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, du/dt = 3600 V/µs (T_{vj} = 150°C), T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 16 Ω, T_{vj} = 150°C	E_{off}		1,20 1,60 1,70		mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 360 V V_{CEmax} = V_{CES} -L_{sCE} ·di/dt, t_P ≤ 6 µs, T_{vj} = 150°C	I_{SC}		330		A
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro IGBT / per IGBT	R_{thJH}		1,40		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{vj\,op}$	-40		150	°C

Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}	650		V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F	30		A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I_{FRM}	60		A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I²t	90,0 82,0		A²s A²s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	I_F = 30 A, V_{GE} = 0 V I_F = 30 A, V_{GE} = 0 V I_F = 30 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	V_F		1,60 1,55 1,50	2,00	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	I_F = 30 A, - di_F/dt = 1100 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	I_{RM}		20,0 26,0 28,0		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	I_F = 30 A, - di_F/dt = 1100 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	Q_r		1,20 2,10 2,50		µC µC µC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	I_F = 30 A, - di_F/dt = 1100 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{rec}		0,22 0,45 0,53		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro Diode / per diode		R_{thJH}		2,60		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\,op}$	-40		150	°C

IGBT,3-Level / IGBT,3-Level

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	650	V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	T_H = 25°C, $T_{vj\,max}$ = 175°C	$I_{C\,nom}$	30	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	60	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	I_C = 30 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 25°C I_C = 30 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 125°C I_C = 30 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 150°C	$V_{CE\,sat}$		1,55 1,80 1,85	1,95	V V V
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	I_C = 0,80 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C	V_{GEth}	5,00	5,80	6,50	V
Gateladung Gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V	Q_G		0,30		µC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	T_{vj} = 25°C	R_{Gint}		0,0		Ω
Eingangskapazität Input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{ies}		1,65		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{res}		0,051		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 650 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C	I_{CES}			1,0	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C	I_{GES}			100	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 20 Ω, T_{vj} = 150°C	$t_{d\,on}$		0,03 0,03 0,031		µs µs µs
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 20 Ω, T_{vj} = 150°C	t_r		0,035 0,036 0,05		µs µs µs
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 20 Ω, T_{vj} = 150°C	$t_{d\,off}$		0,175 0,19 0,20		µs µs µs
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 20 Ω, T_{vj} = 150°C	t_f		0,019 0,038 0,043		µs µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 35 nH, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, di/dt = 830 A/µs (T_{vj} = 150°C), T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 20 Ω, T_{vj} = 150°C	E_{on}		0,38 0,42 0,42		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 35 nH, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, du/dt = 5400 V/µs (T_{vj} = 150°C), T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 20 Ω, T_{vj} = 150°C	E_{off}		0,42 0,64 0,71		mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 360 V V_{CEmax} = V_{CES} -L_{sCE} ·di/dt, t_P ≤ 5 µs, T_{vj} = 150°C	I_{SC}		160		A
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro IGBT / per IGBT	R_{thJH}		2,15		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{vj\,op}$	-40		150	°C

Diode, 3-Level / Diode, 3-Level

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}		650	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F		10	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I_{FRM}		20	A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C	I²t		4,50	A²s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	I_F = 10 A, V_{GE} = 0 V I_F = 10 A, V_{GE} = 0 V I_F = 10 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	V_F		1,45 1,60 1,65	1,85	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	I_F = 10 A, - di_F/dt = 400 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	I_{RM}		6,30 6,80 6,90		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	I_F = 10 A, - di_F/dt = 400 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	Q_r		0,22 0,37 0,40		µC µC µC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	I_F = 10 A, - di_F/dt = 400 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{rec}		0,01 0,01 0,01		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro Diode / per diode		R_{thJH}		3,92		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\,op}$	-40		150	°C

NTC-Widerstand / NTC-Thermistor

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand Rated resistance	T_{NTC} = 25°C	R_{25}		5,00		kΩ
Abweichung von R100 Deviation of R100	T_{NTC} = 100°C, R_{100} = 493 Ω	ΔR/R	-5		5	%
Verlustleistung Power dissipation	T_{NTC} = 25°C	P_{25}			20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\ K))]$	$B_{25/50}$		3375		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\ K))]$	$B_{25/80}$		3411		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\ K))]$	$B_{25/100}$		3433		K

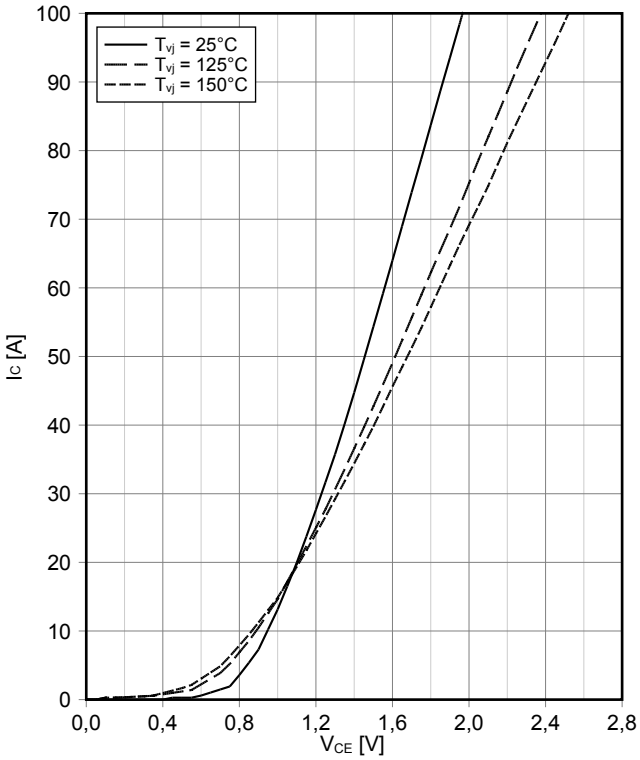
Angaben gemäß gültiger Application Note.
Specification according to the valid application note.

Modul / Module

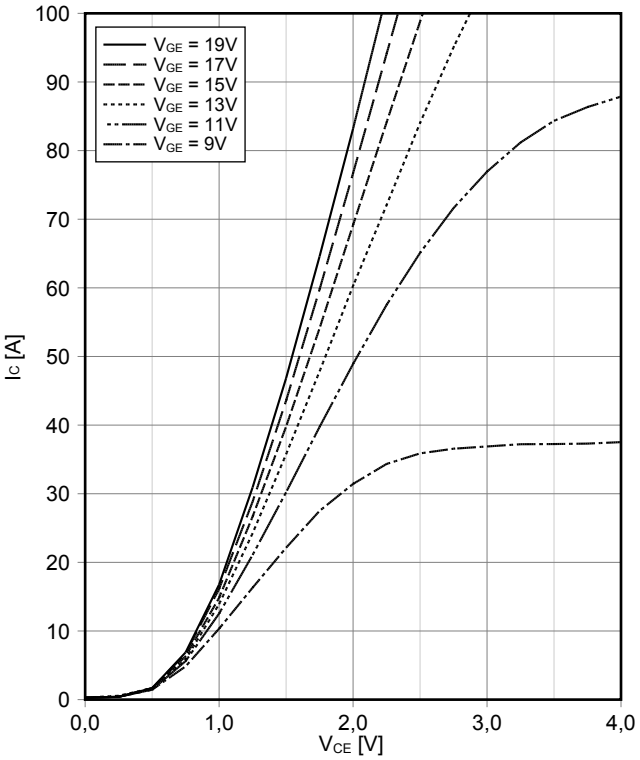
Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}		3,0		kV
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			Al_2O_3		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			11,5 6,3		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			10,0 5,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI		> 200		
			min.	typ.	max.	
Modulstreuinduktivität Stray inductance module		L_{sCE}		45		nH
Lagertemperatur Storage temperature		T_{stg}	-40		125	°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder mountig force per clamp		F	40	-	80	N
Gewicht Weight		G		39		g

Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 25A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.
The current under continuous operation is limited to 25A rms per connector pin

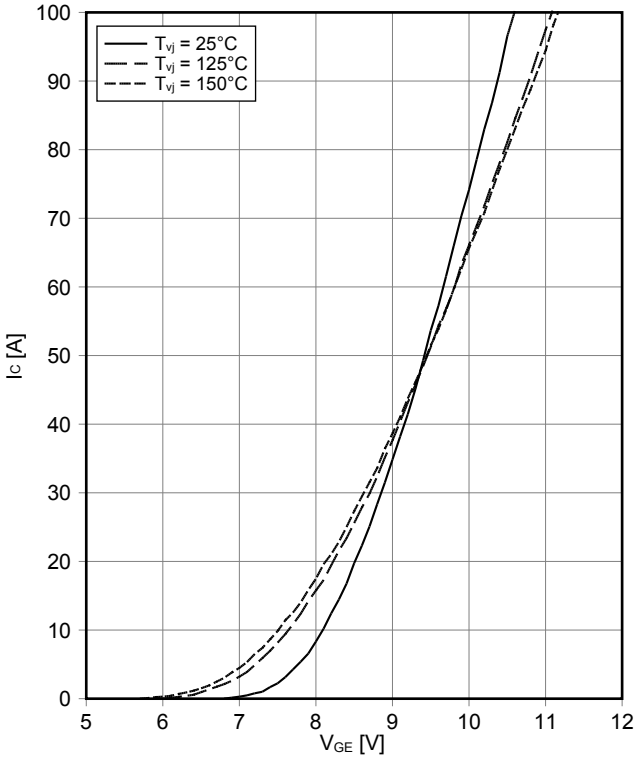
Ausgangskennlinie IGBT,Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



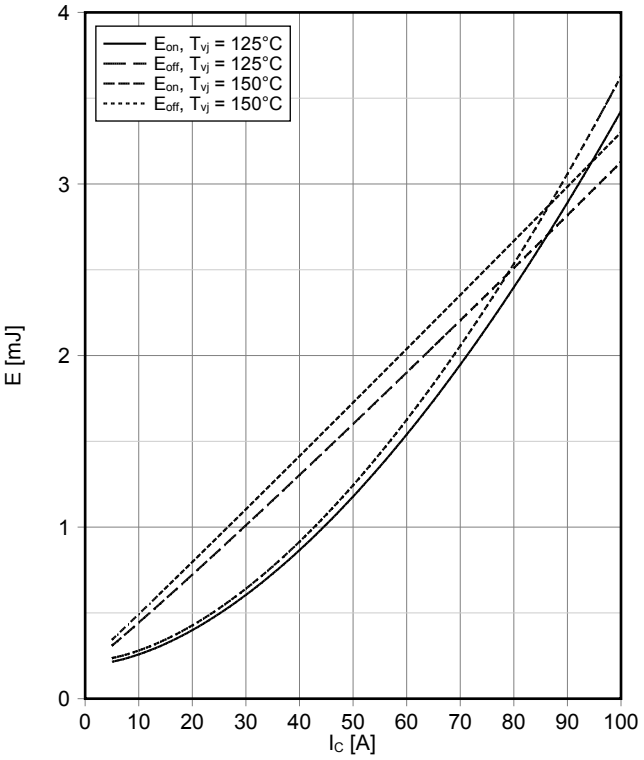
Ausgangskennlinienfeld IGBT,Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 150°C



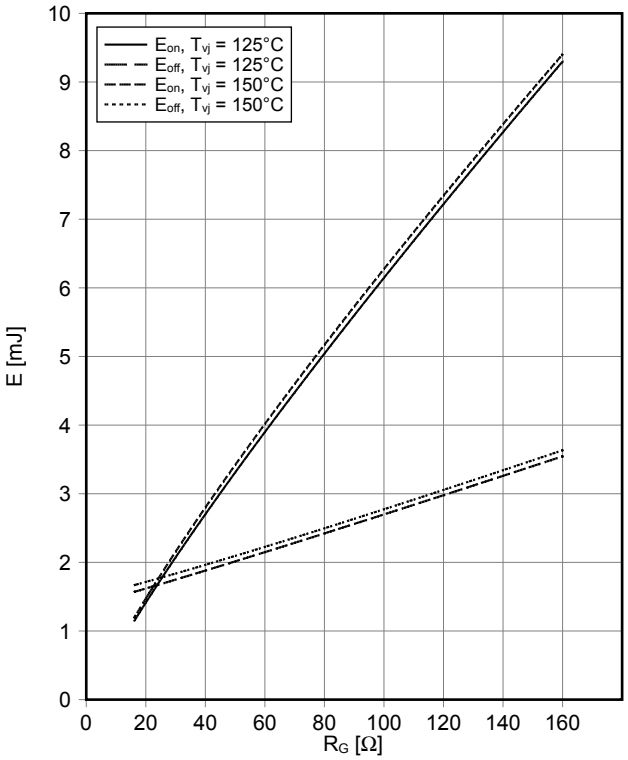
Übertragungscharakteristik IGBT,Wechselrichter (typisch)
transfer characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V



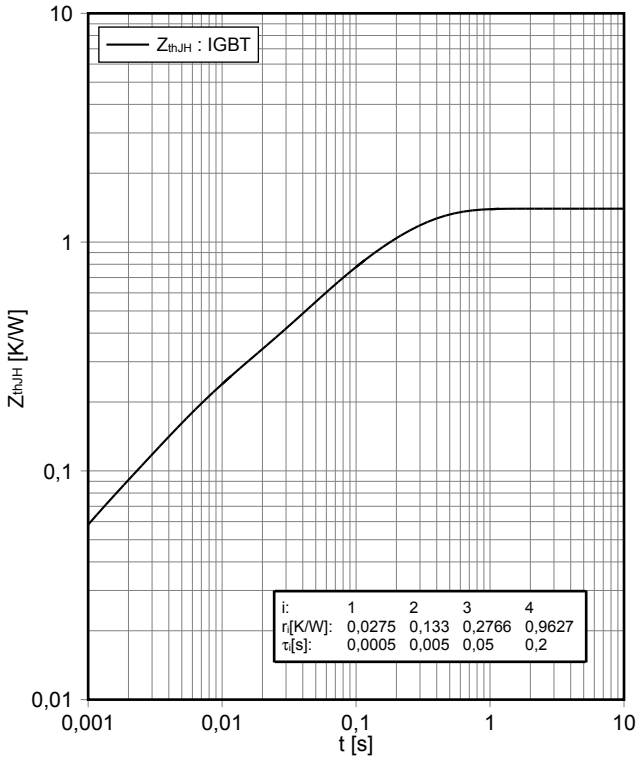
Schaltverluste IGBT,Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT,Inverter (typical)
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 16 Ω, R_{Goff} = 16 Ω, V_{CE} = 300 V



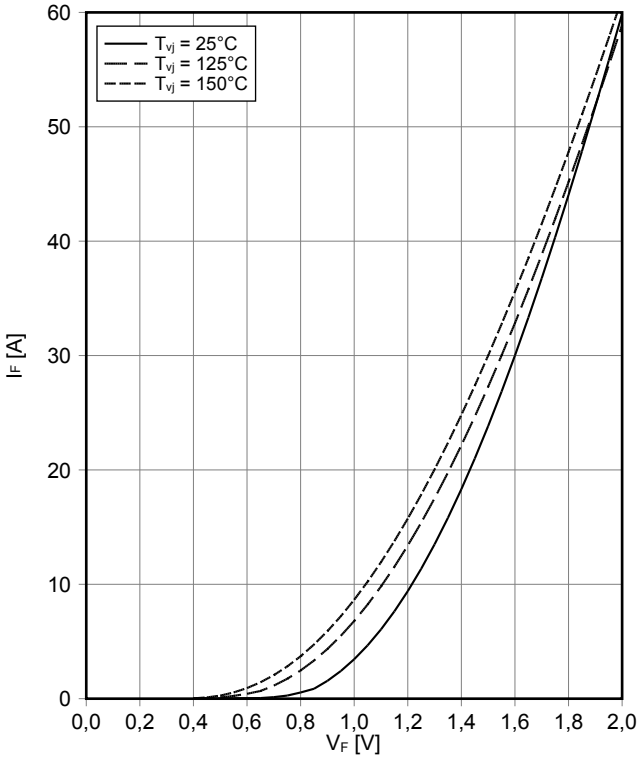
Schaltverluste IGBT,Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT,Inverter (typical)
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
V_{GE} = ±15 V, I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V



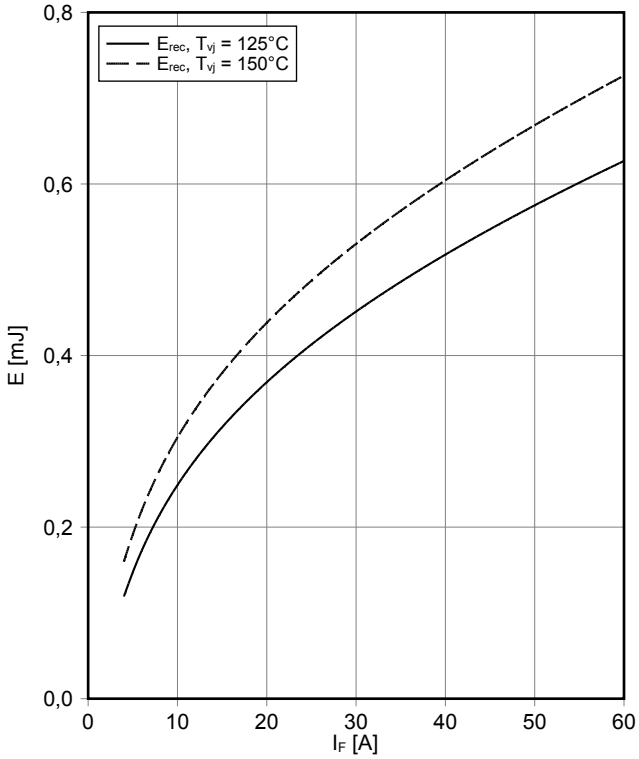
Transienter Wärmewiderstand IGBT,Wechselrichter
transient thermal impedance IGBT,Inverter
$Z_{thJH} = f(t)$



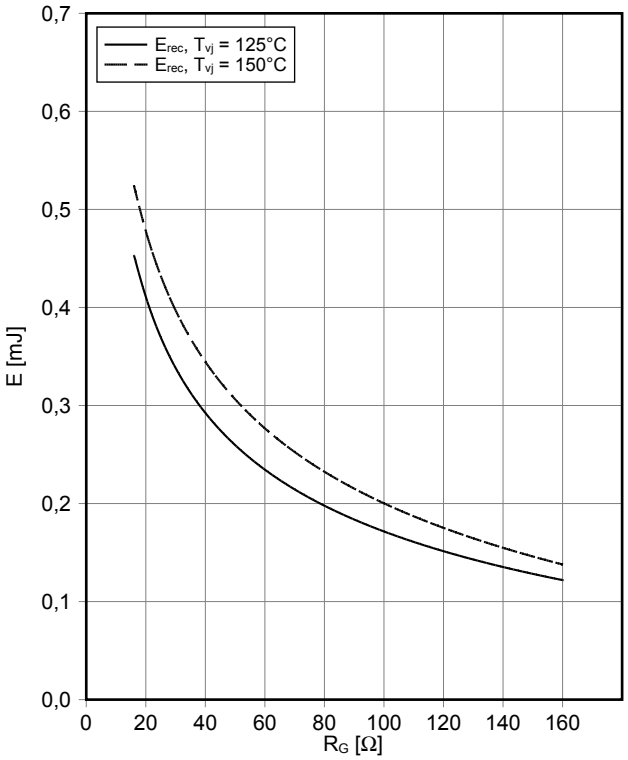
Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)
$I_F = f(V_F)$



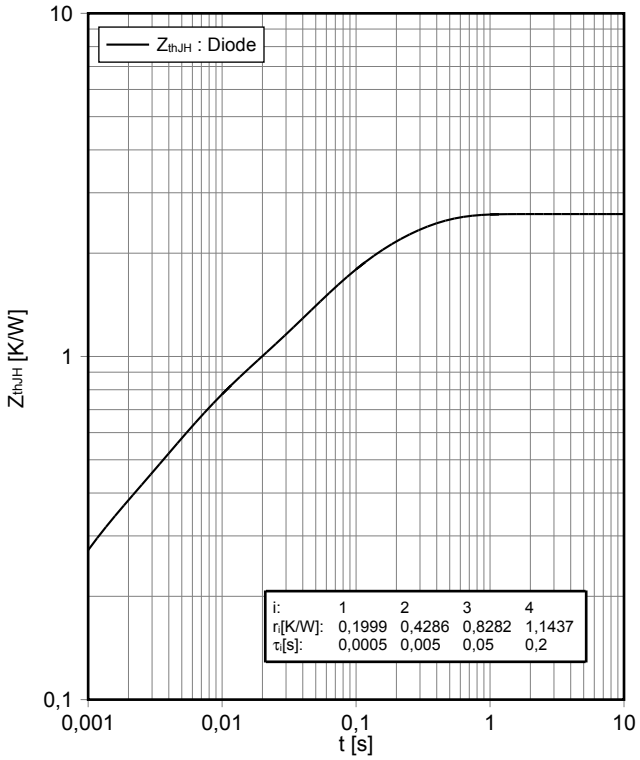
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode, Inverter (typical)
$E_{rec} = f(I_F)$
R_{Gon} = 16 Ω, V_{CE} = 300 V



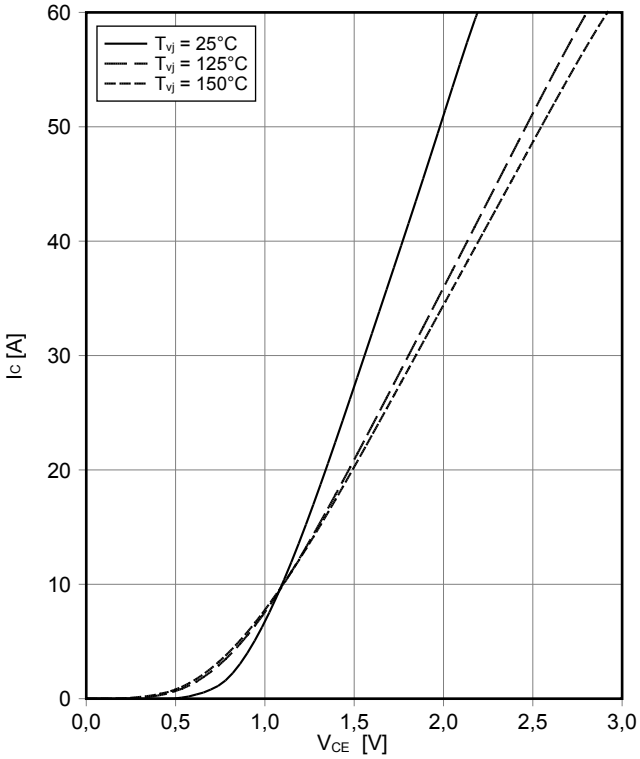
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode, Inverter (typical)
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 30\ A$, $V_{CE} = 300\ V$



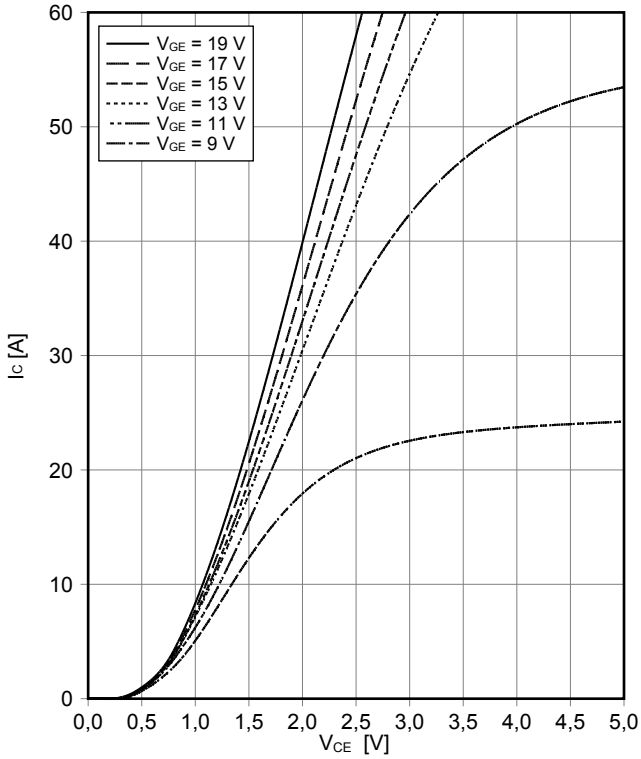
Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter
transient thermal impedance Diode, Inverter
$Z_{thJH} = f(t)$



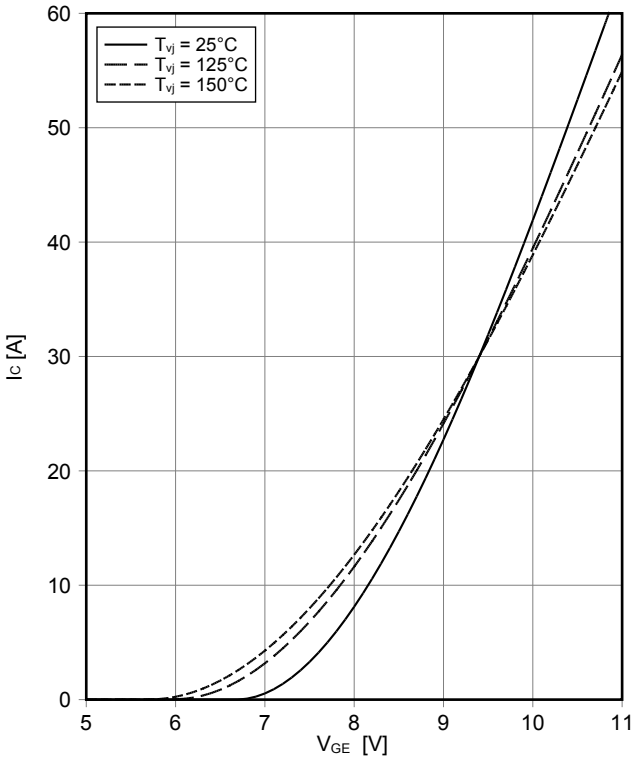
Ausgangskennlinie IGBT,3-Level (typisch)
output characteristic IGBT,3-Level (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
$V_{GE} = 15\ V$



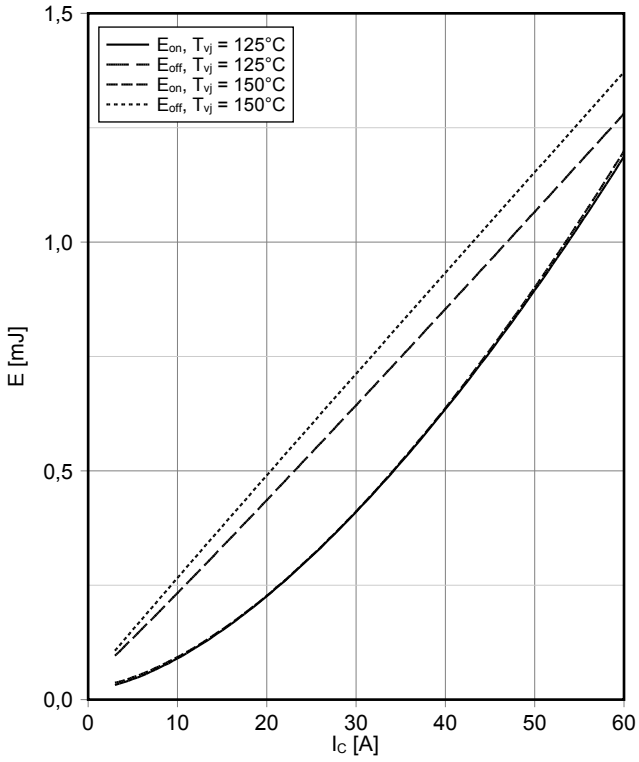
Ausgangskennlinienfeld IGBT,3-Level (typisch)
output characteristic IGBT,3-Level (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
$T_{vj} = 150°C$



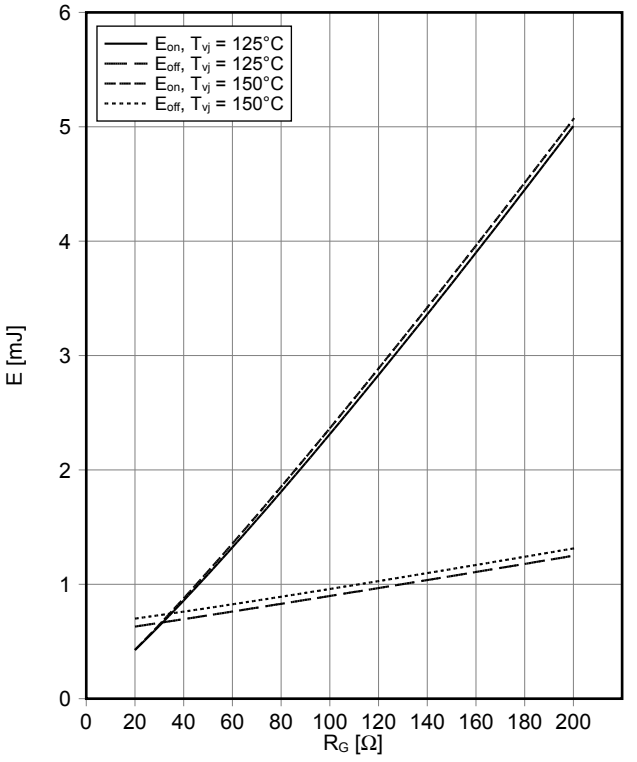
Übertragungscharakteristik IGBT,3-Level (typisch)
transfer characteristic IGBT,3-Level (typical)
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V



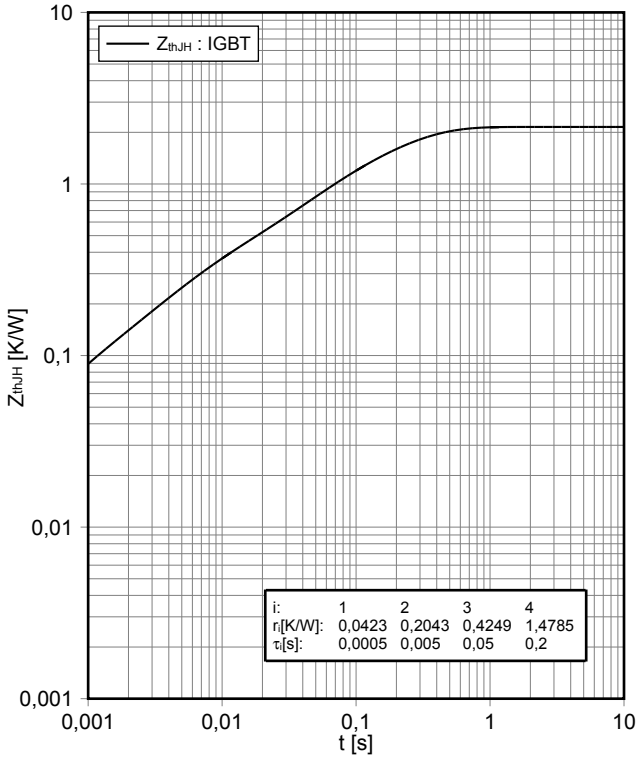
Schaltverluste IGBT,3-Level (typisch)
switching losses IGBT,3-Level (typical)
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 20 Ω, R_{Goff} = 20 Ω, V_{CE} = 300 V



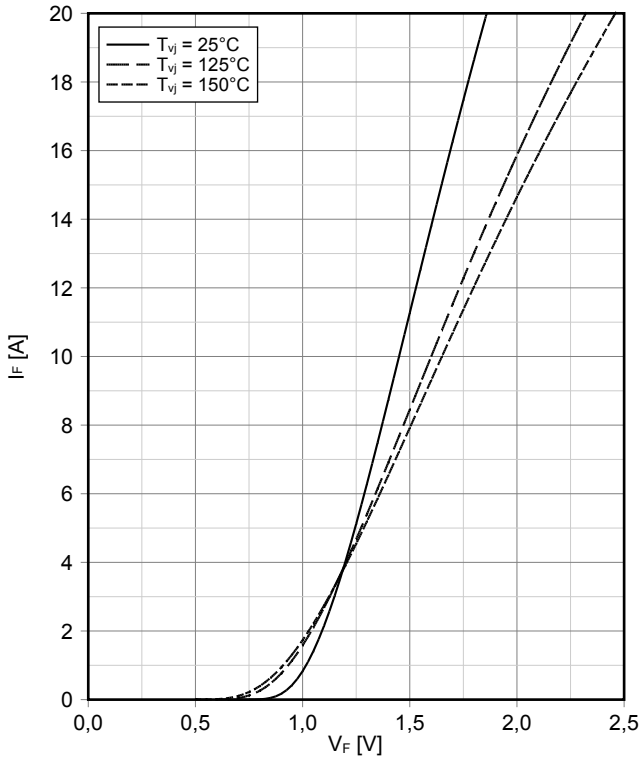
Schaltverluste IGBT,3-Level (typisch)
switching losses IGBT,3-Level (typical)
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
V_{GE} = ±15 V, I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V



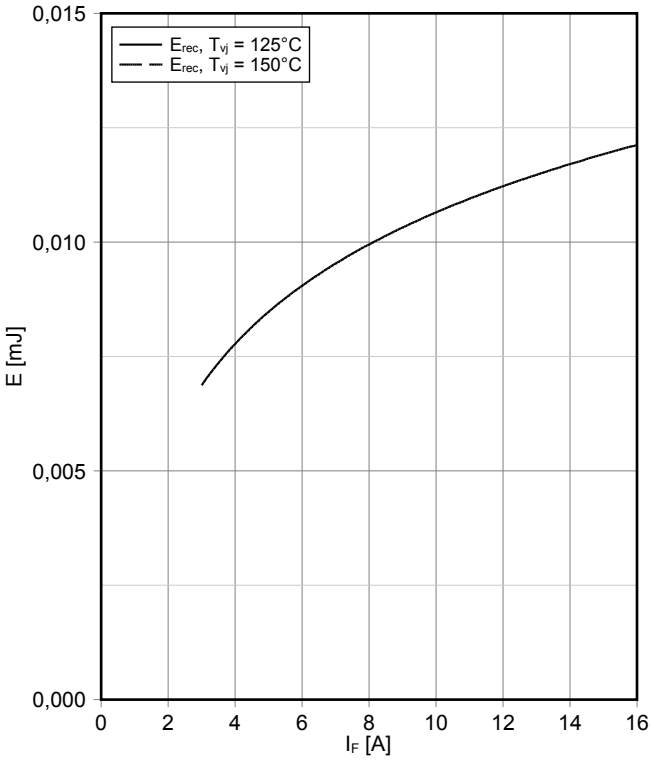
Transienter Wärmewiderstand IGBT,3-Level
transient thermal impedance IGBT,3-Level
$Z_{thJH} = f(t)$



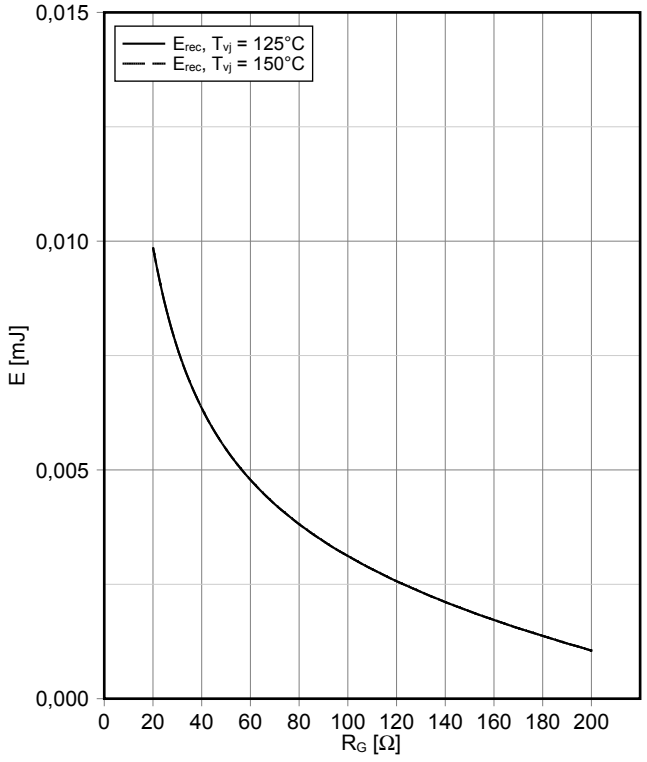
Durchlasskennlinie der Diode, 3-Level (typisch)
forward characteristic of Diode, 3-Level (typical)
$I_F = f(V_F)$



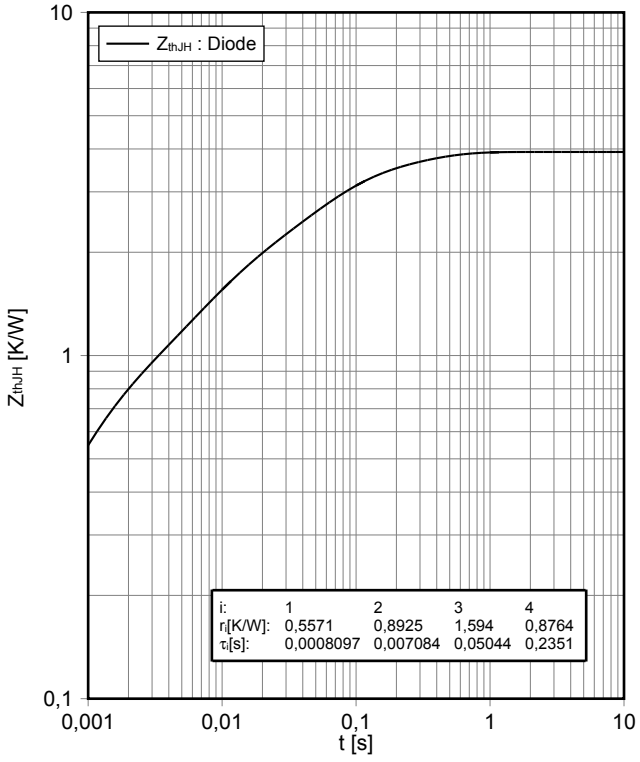
Schaltverluste Diode, 3-Level (typisch)
switching losses Diode, 3-Level (typical)
$E_{rec} = f(I_F)$
$R_{Gon} = 20\ \Omega$, $V_{CE} = 300$ V



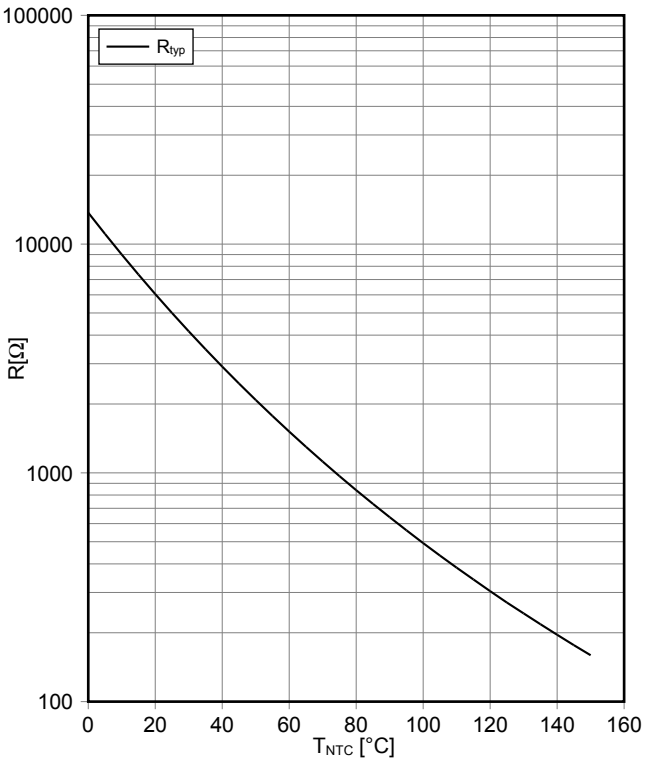
Schaltverluste Diode, 3-Level (typisch)
switching losses Diode, 3-Level (typical)
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 8$ A, $V_{CE} = 300$ V



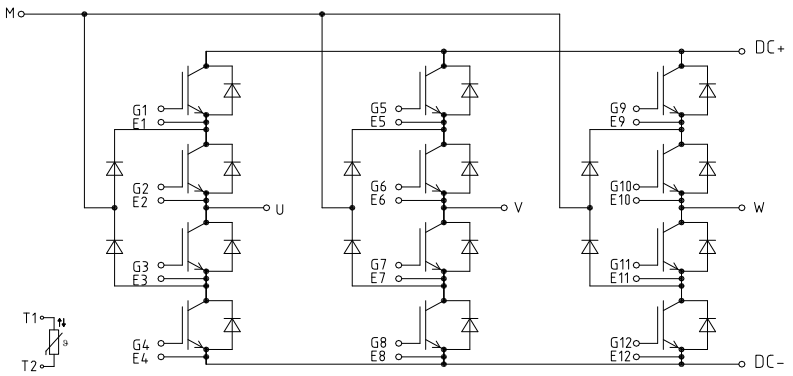
Transienter Wärmewiderstand Diode, 3-Level
transient thermal impedance Diode, 3-Level
$Z_{thJH} = f(t)$



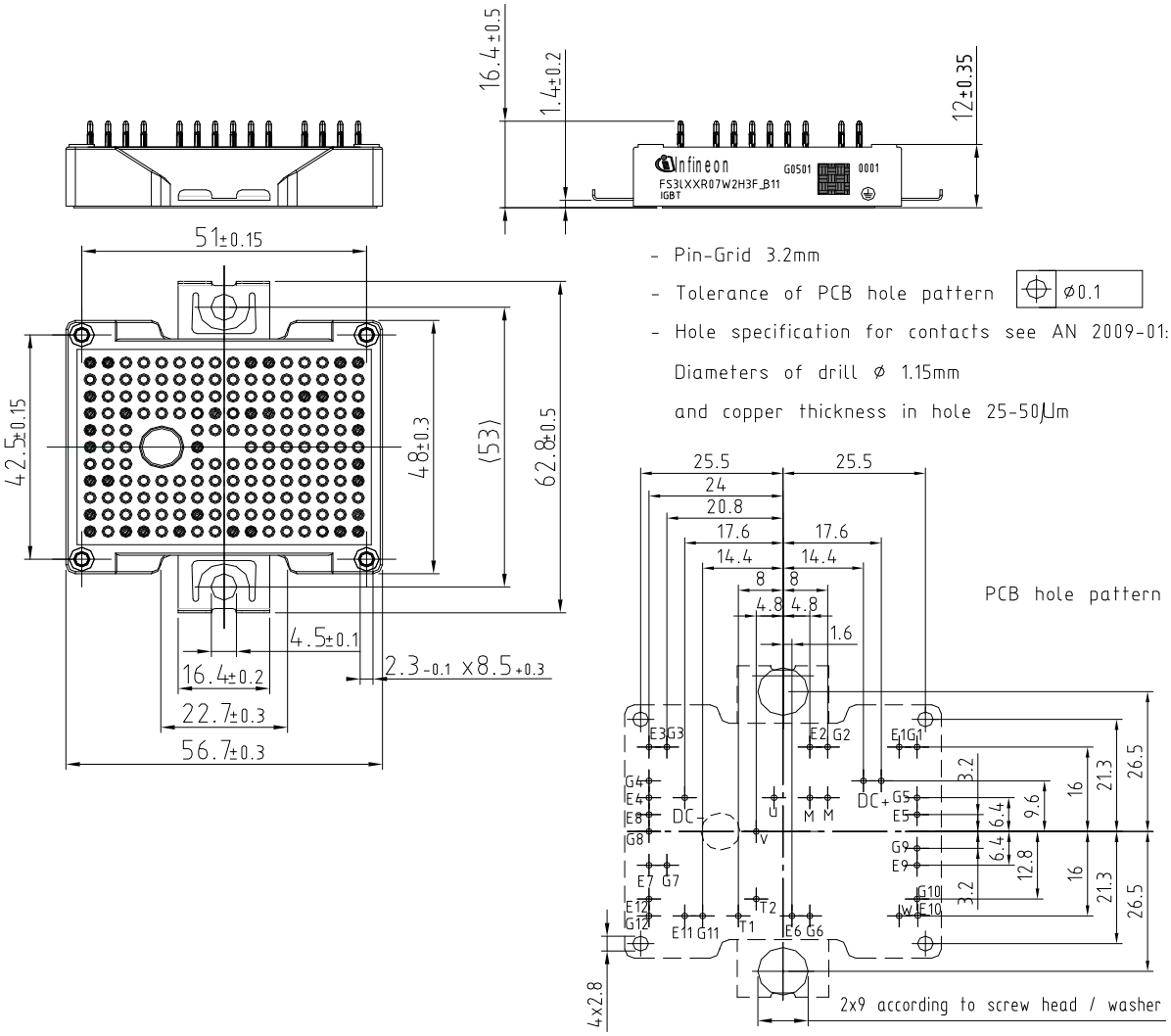
NTC-Widerstand-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)
R = f (T)



Schaltplan / Circuit diagram



Gehäuseabmessungen / Package outlines



Trademarks of Infineon Technologies AG
µHVIC™, µIPM™, µPFC™, AU-ConvertIR™, AURIX™, C166™, CanPAK™, CIPOS™, CIPURSE™, CoolDP™, CoolGaN™, COOLiR™, CoolMOS™, CoolSET™, CoolSiC™, DAVE™, DI-POL™, DirectFET™, DrBlade™, EasyPIM™, EconoBRIDGE™, EconoDUAL™, EconoPACK™, EconoPIM™, EiceDRIVER™, eupec™, FCOS™, GaNpowIR™, HEXFET™, HITFET™, HybridPACK™, iMOTION™, IRAM™, ISOFACE™, IsoPACK™, LEDrivIR™, LITIX™, MIPAQ™, ModSTACK™, my-d™, NovalithIC™, OPTIGA™, OptiMOS™, ORIGA™, PowIRaudio™, PowIRStage™, PrimePACK™, PrimeSTACK™, PROFET™, PRO-SIL™, RASIC™, REAL3™, SmartLEWIS™, SOLID FLASH™, SPOC™, StrongIRFET™, SupIRBuck™, TEMPFET™, TRENCHSTOP™, TriCore™, UHVIC™, XHP™, XMC™

Trademarks updated November 2015

Other Trademarks
All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2017-03-31

Published by
Infineon Technologies AG
81726 München, Germany

© 2017 Infineon Technologies AG.
All Rights Reserved.

Do you have a question about this document?
Email: erratum@infineon.com

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes (“Beschaffenheitsgarantie“) dar. Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Sollten Sie von uns weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Produkt, der Technologie, Lieferbedingungen bzw. Preisen benötigen, wenden Sie sich bitte an das nächste Vertriebsbüro von Infineon Technologies (www.infineon.com).

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.

IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics (“Beschaffenheitsgarantie”). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer’s compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer’s products and any use of the product of Infineon Technologies in customer’s applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer’s technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies’ products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.